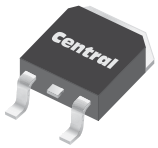
CJD44H11 NPN
CJD45H11 PNP

SURFACE MOUNT
COMPLEMENTARY SILICON
POWER TRANSISTORS



DPAK TRANSISTOR CASE

Central Semiconductor Corp.

www.centralsemi.com

DESCRIPTION:
The CENTRAL SEMICONDUCTOR CJD44H11, CJD45H11 types are Complementary Silicon Power Transistors manufactured in a surface mount package designed for switching and power amplifier applications.

MARKING: FULL PART NUMBER

MAXIMUM RATINGS: (T_C=25ºC unless otherwise noted)	**SYMBOL**		**UNITS**
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	80	V
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	5.0	V
Continuous Collector Current	I_C	8.0	A
Peak Collector Current	I_{CM}	16	A
Power Dissipation	P_D	20	W
Power Dissipation (T_A=25ºC)	P_D	1.75	W
Operating and Storage Junction Temperature	T_J, T_{stg}	-65 to +150	ºC
Thermal Resistance	Θ_{JC}	6.25	ºC/W
Thermal Resistance	Θ_{JA}	71.4	ºC/W

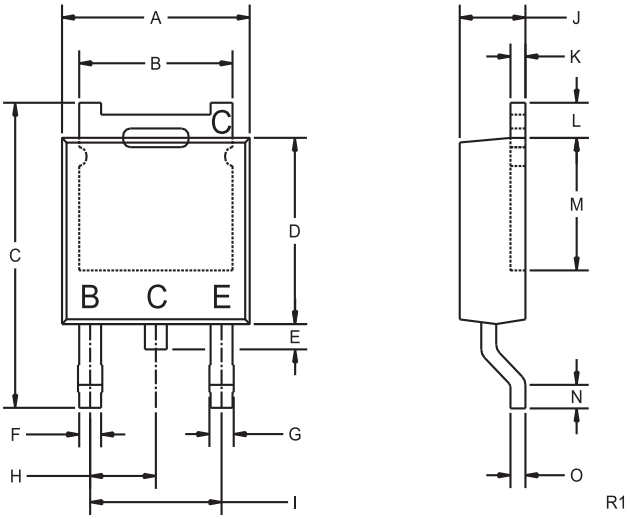
ELECTRICAL CHARACTERISTICS: (T_C=25ºC unless otherwise noted)

SYMBOL	**TEST CONDITIONS**	**MIN**	**TYP**	**MAX**	**UNITS**
I_{CES}	V_{CE}=80V			10	µA
I_{EBO}	V_{EB}=5.0V			50	µA
BV_{CEO}	I_C=30mA	80			V
$V_{CE(SAT)}$	I_C=8.0A, I_B=400mA			1.0	V
$V_{BE(SAT)}$	I_C=8.0A, I_B=800mA			1.5	V
h_{FE}	V_{CE}=1.0V, I_C=2.0A	60			
h_{FE}	V_{CE}=1.0V, I_C=4.0A	40			
f_T	V_{CE}=10V, I_C=500mA, f=20MHz (CJD44H11)		60		MHz
f_T	V_{CE}=10V, I_C=500mA, f=20MHz (CJD45H11)		50		MHz
C_{ob}	V_{CB}=10V, I_E=0, f=0.1MHz (CJD44H11)		120		pF
C_{ob}	V_{CB}=10V, I_E=0, f=0.1MHz (CJD45H11)		220		pF
$t_d + t_r$	I_C=5.0A, I_{B1}=500mA (CJD44H11)		320		ns
$t_d + t_r$	I_C=5.0A, I_{B1}=500mA (CJD45H11)		150		ns
t_s	I_C=5.0A, I_{B1}=I_{B2}=500mA (CJD44H11, CJD45H11)		450		ns
t_f	I_C=5.0A, I_{B1}=I_{B2}=500mA (CJD44H11)		130		ns
t_f	I_C=5.0A, I_{B1}=I_{B2}=500mA (CJD45H11)		100		ns

CJD44H11 NPN
CJD45H11 PNP

SURFACE MOUNT
COMPLEMENTARY SILICON
POWER TRANSISTORS

DPAK TRANSISTOR CASE - MECHANICAL OUTLINE



DIMENSIONS				
	INCHES		MILLIMETERS	
SYMBOL	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.250	0.265	6.35	6.73
B	0.205	0.215	5.21	5.46
C	0.374	0.409	9.50	10.40
D	0.235	0.245	5.97	6.22
E	0.025	0.040	0.64	1.02
F	0.025	0.035	0.64	0.88
G	0.030	0.045	0.76	1.14
H	0.090		2.28	
I	0.180		4.57	
J	0.086	0.094	2.19	2.38
K	0.018	0.023	0.46	0.58
L	0.040	0.050	1.02	1.27
M	0.170	-	4.32	-
N	0.020	-	0.51	-
O	0.018	0.023	0.46	0.58

DPAK TRANSISTOR (REV: R1)

LEAD CODE:
B) BASE
C) COLLECTOR
E) EMITTER
C) COLLECTOR

MARKING:
FULL PART NUMBER

R2 (4-January 2010)

Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.

Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-02-42
Электронная почта: org@eplast1.ru
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.